

IEEE EDS Kansai Chapterの皆様
IEEE Kansai Section の皆様

2018年12月27日
IEEE EDS Kansai Chapter Chair 中村 孝
Vice Chair 吉本 昌広

下記の通り、第18回「関西コロキウム電子デバイスワークショップ」を開催致します。
会員の皆様のご参加をお待ち申し上げます。

記

会議名: 第18回「関西コロキウム電子デバイスワークショップ」
主 催: IEEE Electron Devices Society Kansai Chapter
日 時: 2019年1月24日(木) 10:20~16:25
会 場: 龍谷大学大阪梅田キャンパス セミナールーム
場 所: 〒530-0001 大阪市北区梅田2-2-2 ヒルトンプラザウエストオフィスタワー14階

プログラム: 次ページ以降参照
公用語: 日本語
会 費: 無料(事前登録不要)

[お問い合わせ先]
IEEE EDS Kansai Chapter Secretary: 西中 浩之 (京都工芸繊維大学; nisinaka[at]kit.ac.jp)

=====

<ご講演頂く皆様へ>

講演時間: 20分 + 質疑: 5分 (全て日本語)

使用器具: 講演で使用していただくPCは原則ご持参ください。もしご都合が悪いようでしたら、事前に鎌倉(阪大; kamakura@si.eei.eng.osaka-u.ac.jp)までご連絡ください。その場合、Power Pointデータを事前に上記アドレス宛お送りいただくか、当日USBスティックメモリをご持参ください。
当日、特別な資料をご用意いただく必要はありません。

開会挨拶 [10:20 - 10:25]

中村 孝 (大阪大学)

Session I.

座長: 鎌倉 良成 (大阪大学)

10:25 Study on the impacts of hole injection and inclusion of sub-oxide and metallic Si atoms on repeatable resistance switching of sputter-deposited silicon oxide films [IEEE-TDMR]

Y. Omura, R. Yamaguchi, and S. Sato
Kansai Univ.

**10:50 ~ IEEE EDS Kansai Chapter of the Year Award ~
Reliability-aware design of metal/high-k gate stack for high-performance SiC MOSFET [ISPSD]**

T. Hosoi, S. Azuno, Y. Kashiwagi, S. Hosaka, K. Yamamoto, M. Aketa,
H. Asahara, T. Nakamura, T. Kimoto, T. Shimura, and H. Watanabe
Osaka Univ.

11:15 Back-side illuminated GeSn photodiode array on quartz substrate fabricated by laser-induced liquid-phase crystallization for monolithically-integrated NIR imager chip [IEDM]

H. Oka, K. Inoue, T. T. Nguyen, S. Kuroki, T. Hosoi, T. Shimura, and H. Watanabe
Osaka Univ.

**11:40 ~ IEEE EDS Kansai Chapter MFSK Award ~
Chemical sensing using graphene-based surface-acoustic-wave sensor [SSDM]**

S. Okuda, T. Ono, Y. Kanai, M. Shimatani, S. Ogawa, T. Ikuta, K. Inoue,
K. Maehashi, and K. Matsumoto
Osaka Univ.

AWARD授与 [12:05-12:20]

上田 尚宏 (リコー電子デバイス)

— 昼食 [12:20 - 13:30] —

Session II.

座長: 安藤 友一 (リコー)

13:30 CMOS-based optical energy harvesting circuit for implantable and IoT devices [SSDM]

W. Nattakarn, M. Haruta, T. Noda, K. Sasagawa, T. Tokuda, M. Sawan, and J. Ohta
Nara Institutes of Science and Technology

13:55 Al-foil-based low-loss coplanar waveguides directly bonded to sapphire substrates [SSDM]

K. Matsuura, J. Liang, K. Maezawa, and N. Shigekawa
Osaka City Univ.

— 休憩 [14:20 - 14:30] —

Session III.

座長：古橋 壮之（三菱電機）

- 14:30** **6.5 kV Schottky-barrier-diode-embedded SiC-MOSFET for compact full-unipolar module [ISPSD]**
K. Kawahara, S. Hino, K. Sadamatsu, Y. Nakao, Y. Yamashiro, Y. Yamamoto, T. Iwamatsu, S. Nakata, S. Tomohisa, and S. Yamakawa
Mitsubishi Electric Corp.
- 14:55** **Fast switching performance by 20 A / 730 V AlGaIn/GaN MIS-HFET using AlON gate insulator [IEDM]**
S. Nakazawa, H.-A. Shih, N. Tsurumi, Y. Anda, H. Hatsuda, T. Ueda, M. Nozaki, T. Yamada, T. Hosoi, T. Shimura, H. Watahabe, and T. Hashizume
Panasonic Corp.

— 休憩 [15:20 - 15:30] —

Session IV.

座長：木村 睦（龍谷大学）

- 15:30** **Slave flexible micro-finger integrated with sensor for master-slave sense presentaion system [Transducers]**
R. Kawashima, S. Hagimori, A. Sato, and S. Konishi
Ritsumeikan Univ.
- 15:55** **High reliability a-InGaZnO TFT by inductively coupled plasma sputtering system [AM-FPD]**
D. Matsuo, S. Kishida, Y. Setogucti, Y. Ando, R. Miyanaga, M. N. Fujii, and Y. Uraoka
Nissin Electric Co., Ltd.

閉会挨拶 [16:20-16:25]

中村 孝（大阪大学）